

	<p>SIR808DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR808DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIR808DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 22442 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIR808DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22442 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	29.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	815pF @ 12.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 20A (Tc) 29.8W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SIR808DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR808DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR808DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIR808DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR812DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR802DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR814DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR814DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR812DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR804DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR804DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SIR808DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK</p>

SIR808DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR808DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR808DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR808DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR808DP-T1-GE3
SIR808DP-T1-GE3 Electronic	SIR808DP-T1-GE3-Komponenten	SIR808DP-T1-GE3-Verteiler	SIR808DP-T1-GE3-Bild	SIR808DP-T1-GE3-Aktie	SIR808DP-T1-GE3-Teil
SIR808DP-T1-GE3 Preis	SIR808DP-T1-GE3 Hersteller	SIR808DP-T1-GE3 Bild	SIR808DP-T1-GE3 Aktie	SIR808DP-T1-GE3 Inventar	SIR808DP-T1-GE3 Online bestellen
SIR808DP-T1-GE3 Neu	SIR808DP-T1-GE3 Original	SIR808DP-T1-GE3 garantiert	SIR808DP-T1-GE3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited